

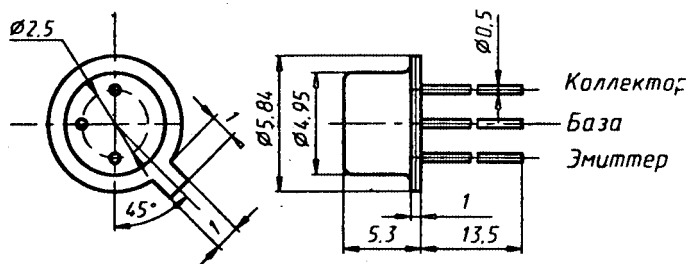
КТ3117А, КТ3117Б, КТ3117А1

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* импульсные. Предназначены для применения в импульсных и переключающих устройствах. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами (КТ3117А, КТ3117Б) и в пластмассовом корпусе с гибкими выводами (КТ3117А1). Тип прибора указывается на корпусе и в этикетке.

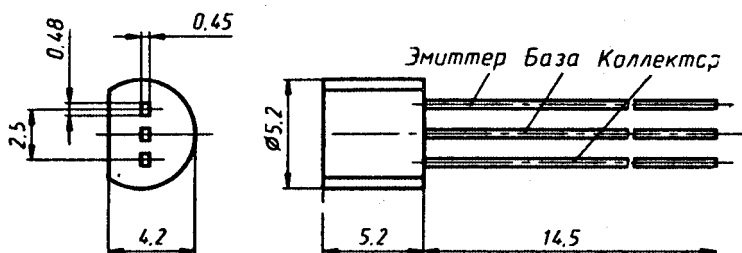
Масса транзистора в металлостеклянном корпусе не более 0,4 г, в пластмассовом корпусе не более 0,3 г.

Изготовитель — завод «Транзистор», г. Минск.

КТ3117(А Б).



КТ3117А1



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кз} = 5$ В, $I_b = 200$ мА:

$T = +25$ °С:

КТ3117А, КТ3117А1 40...200

КТ3117Б 100...300

$T = T_{мин}$:

КТ3117А, КТ3117А1 15...200

$T = T_{макс}$:

КТ3117А, КТ3117А1 30...350

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кз} = 10$ В, $I_k = 30$ мА, не менее 200 МГц

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_k = 500$ мА, $I_b = 50$ мА, не более 0,6 В

Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_k = 500$ мА, $I_b = 50$ мА, не более 1,2 В

Время включения при $I_k = 500$ мА, $I_b = 50$ мА для КТ3117Б, не более 35 нс

Время рассасывания при $I_k = 500$ мА, $I_b = 50$ мА, не более	80 нс
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 10$ В, не более	10 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 0$, не более	80 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 60$ В, не более:	
$T = +25$ °С	10 мкА
$T = T_{\text{макс}}$	100 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 4$ В, не более	5 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:	
КТ3117А, КТ3117А1	60 В
КТ3117Б	75 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер:	
$R_{бэ} = 0$:	
КТ3117А, КТ3117А1	60 В
КТ3117Б	75 В
$R_{бэ} = 1$ кОм:	
КТ3117А, КТ3117А1	50 В
КТ3117Б	65 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	4 В
Импульсное напряжение эмиттер—база при $t_n = 1$ мкс, $Q = 2$	5 В
Постоянный ток коллектора	400 мА
Импульсный ток коллектора при $t_n = 10$ мкс, $Q = 10$	800 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора ¹ :	
$T = +40$ °С	300 мВт
$T = +85$ °С	180 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность коллек- тора ¹ при $t_n = 10$ мкс, $Q = 10$:	
$T = +40$ °С	800 мВт
$T = +85$ °С	400 мВт
Тепловое сопротивление:	
переход—среда	0,35 °С/мВт
переход—корпус	0,1 °С/мВт
Температура р-п перехода	+150 °С
Температура окружающей среды	-45...+85 °С

¹ При T от +40 до +85 °С максимально допустимые постоянные и импульсные рассеиваемые мощности коллектора уменьшаются линейно.